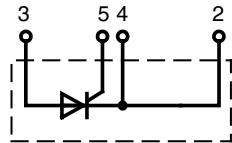


High Power Single Thyristor Modules

I_{FRMS} = **880 A**
I_{FAVM} = **560 A**
V_{RRM} = **1200-1800 V**

V _{RSM} V	V _{RRM} V	Type
1300	1200	MCO 500-12io1
1500	1400	MCO 500-14io1
1700	1600	MCO 500-16io1
1900	1800	MCO 500-18io1



E72873

Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
I _{TRMS}	T _{VJ} = T _{VJM}	880	A	
I _{T(AV)M}	180° sine	560	A	
I _{TSM}	T _{VJ} = 45°C; t = 10 ms (50 Hz) V _R = 0 t = 8.3 ms (60 Hz)	17000	A	
	T _{VJ} = T _{VJM} ; t = 10 ms (50 Hz) V _R = 0 t = 8.3 ms (60 Hz)	16000	A	
		13000	A	
		14400	A	
I ² t	T _{VJ} = 45°C; t = 10 ms (50 Hz) V _R = 0 t = 8.3 ms (60 Hz)	1 445 000	A ² s	
	T _{VJ} = T _{VJM} ; t = 10 ms (50 Hz) V _R = 0 t = 8.3 ms (60 Hz)	1 062 000	A ² s	
(di/dt) _{cr}	T _{VJ} = T _{VJM} ; repetitive, I _T = 960 A f = 50 Hz; t _p = 200 µs;	100	A/µs	
	V _D = 2/3 V _{DRM} ; I _G = 1 A; non repetitive, I _T = I _{TAVM} di _G /dt = 1 A/µs	500	A/µs	
(dv/dt) _{cr}	T _{VJ} = T _{VJM} ; V _D = 2/3 V _{DRM} ; R _{GK} = ∞; method 1 (linear voltage rise)	1000	V/µs	
P _{GM}	T _{VJ} = T _{VJM} ; t _p = 30 µs I _T = I _{T(AV)M} ; t _p = 500 µs	120	W	
		60	W	
P _{GAV}		30	W	
V _{RGM}		10	V	
T _{VJ}		-40...+140	°C	
T _{VJM}		140	°C	
T _{stg}		-40...+125	°C	
V _{ISOL}	50/60 Hz, RMS t = 1 min I _{ISOL} ≤ 1 mA t = 1 s	3000	V~	
		3600	V~	
M _d	Mounting torque (M6) Terminal connection torque (M8)	4.5 - 7	Nm	
		11-13	Nm	
Weight	Typical including screws	650	g	

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© 2012 IXYS All rights reserved

20121206e

1 - 4

Symbol	Conditions	Characteristic Values	
		typ.	max.
I_{RRM}	$V_R = V_{RRM}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	40 mA
V_T	$I_T = 1200 \text{ A}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	1.3 V
V_{TO}	For power-loss calculations only		0.8 V
r_t		$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.38 mΩ
V_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 V
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	3 V
I_{GT}	$V_D = 6 \text{ V}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	300 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ\text{C}$	400 mA
V_{GD}	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM};$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	0.25 V
I_{GD}			10 mA
I_L	$t_p = 30 \mu\text{s}; V_D = 6 \text{ V}$ $I_G = 1 \text{ A}; di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	400 mA
I_H	$V_D = 6 \text{ V}; R_{GK} = \infty;$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	300 mA
t_{gd}	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$ $I_G = 1 \text{ A}; di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	2 μs
t_q	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $dv/dt = 50 \text{ V}/\mu\text{s}; -di/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ $I_T = 500 \text{ A}; V_R = 100 \text{ V}; t_p = 200 \mu\text{s}$	$T_{VJ} = T_{VJM}$	350 μs
R_{thJC}	DC current		0.072 K/W
R_{thJK}	DC current		0.096 K/W
d_s	Creeping distance on surface		12.7 mm
d_A	Creepage distance in air		9.6 mm
a	Maximum allowable acceleration		50 m/s ²

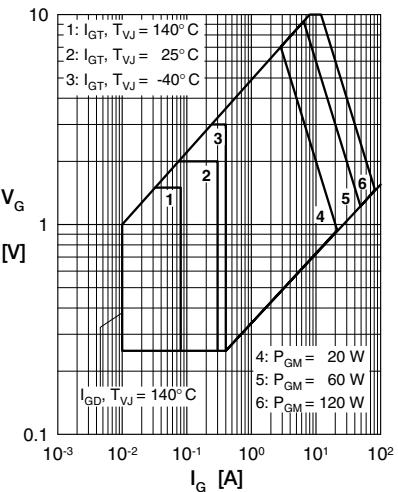


Fig. 1 Gate trigger characteristics

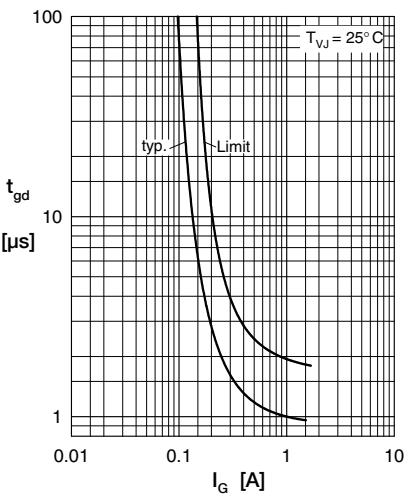
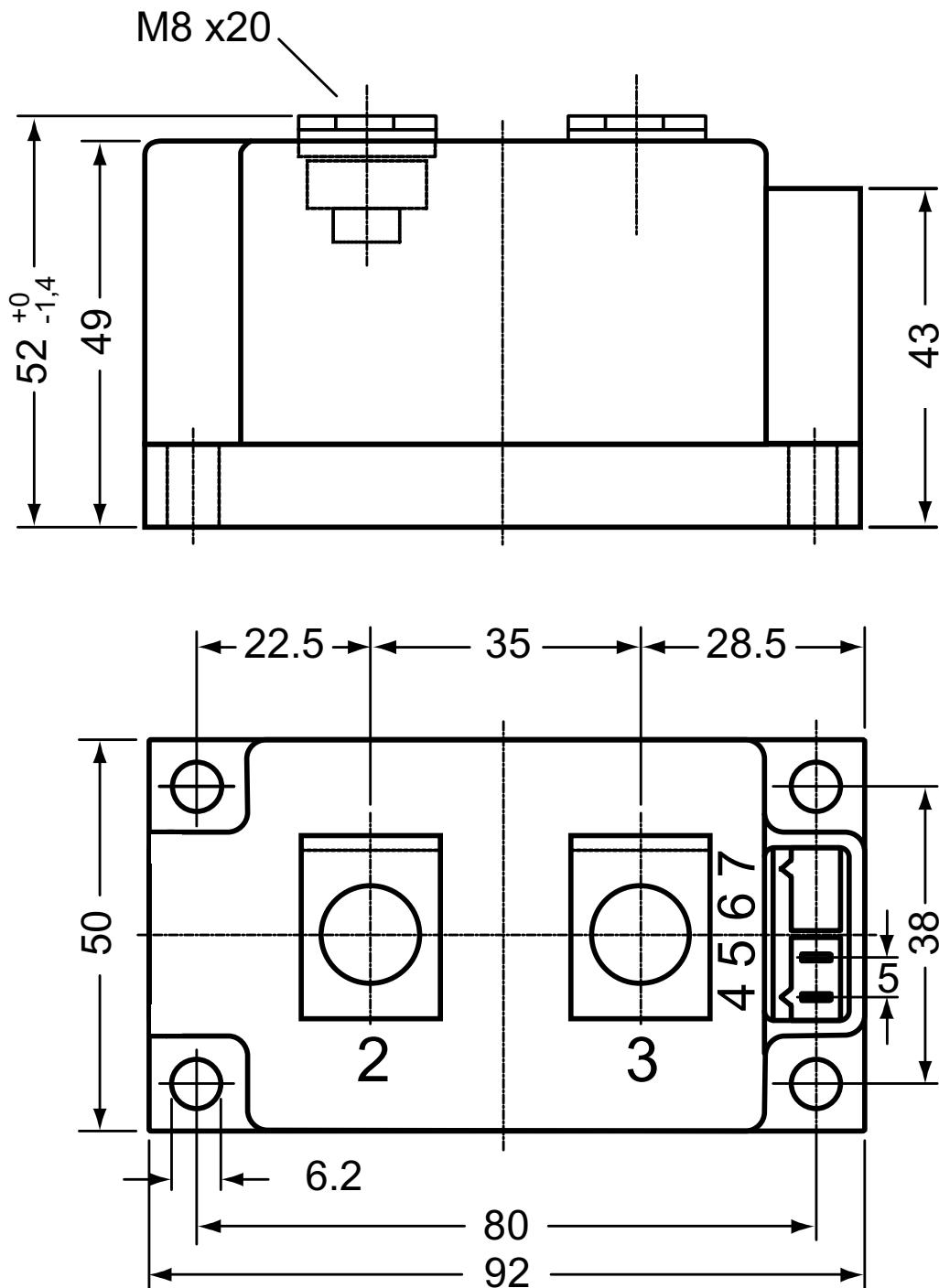


Fig. 2 Gate trigger delay time

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



Optional accessories for modules

Keyed gate/cathode twin plugs with wire length = 350 mm, gate = white, cathode = red
Type ZY 180L (L = Left for pin pair 4/5)
Type ZY 180R (R = Right for pin pair 6/7) } UL 758, style 3751

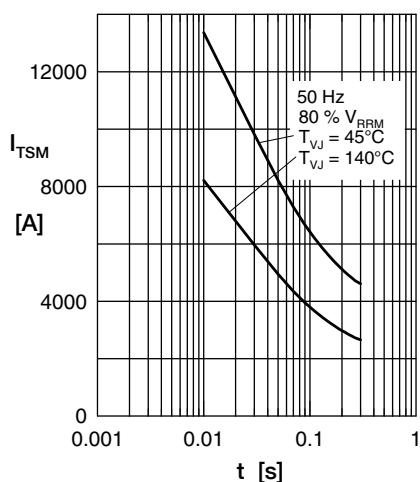


Fig. 3 Surge overload current
 I_{TSM} : Crest value, t: duration

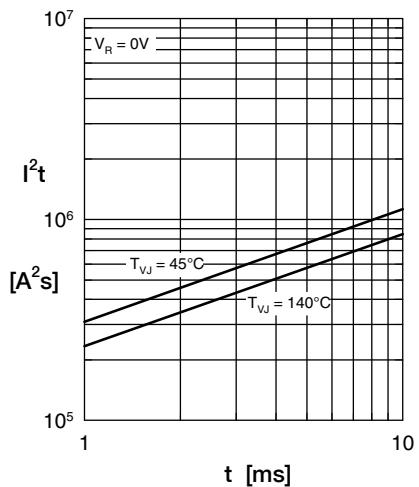


Fig. 4 I^2t versus time (1-10 ms)

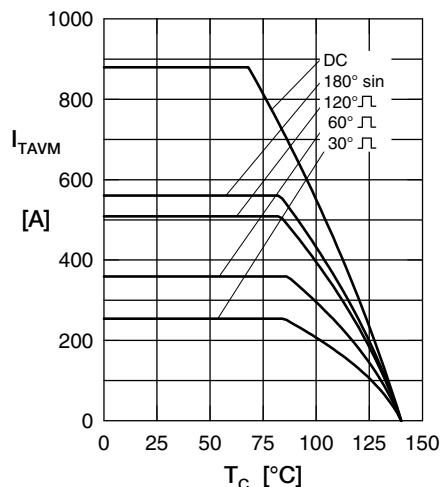


Fig. 5 Maximum forward current
at case temperature

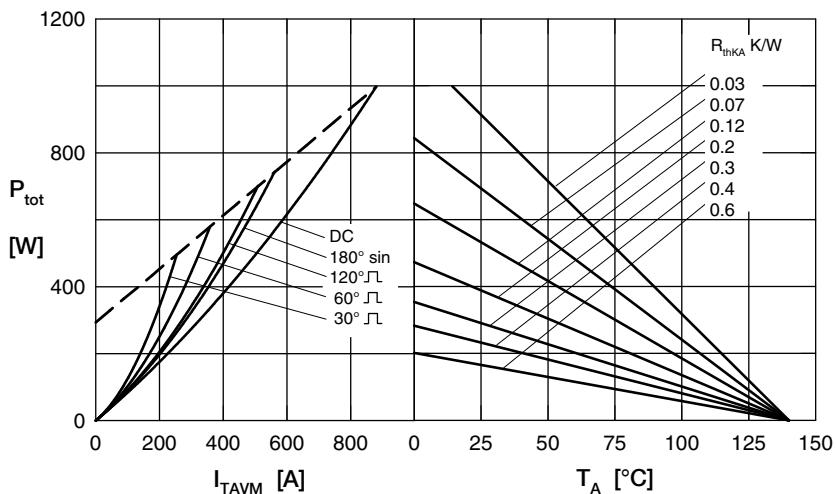


Fig. 6 Power dissipation versus on-state current & ambient temperature

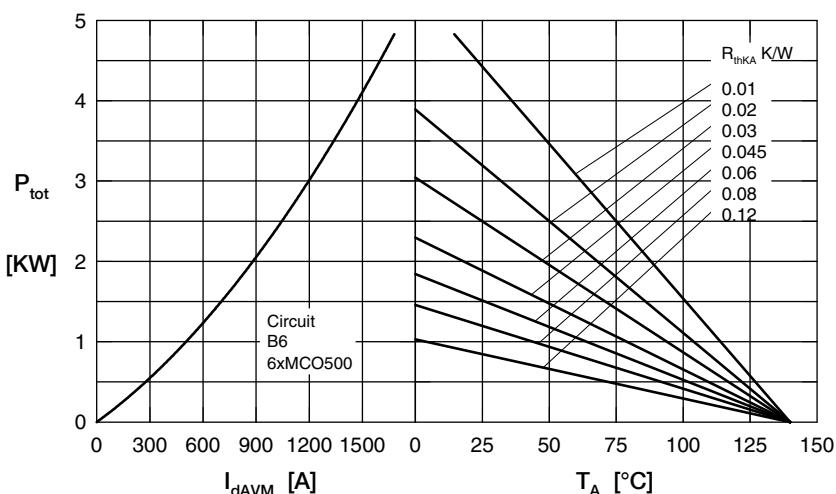


Fig. 7 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus
direct output current and ambient temperature

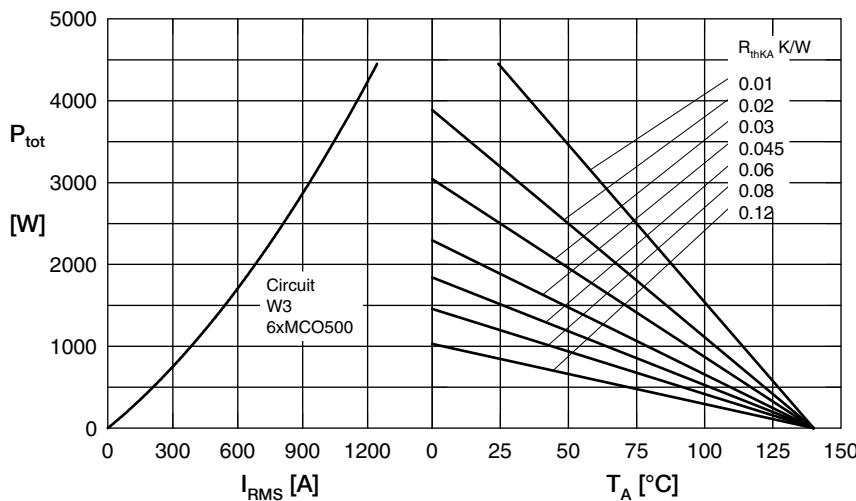


Fig. 8 Three phase AC-controller: Power dissipation versus RMS output current and ambient temperatur

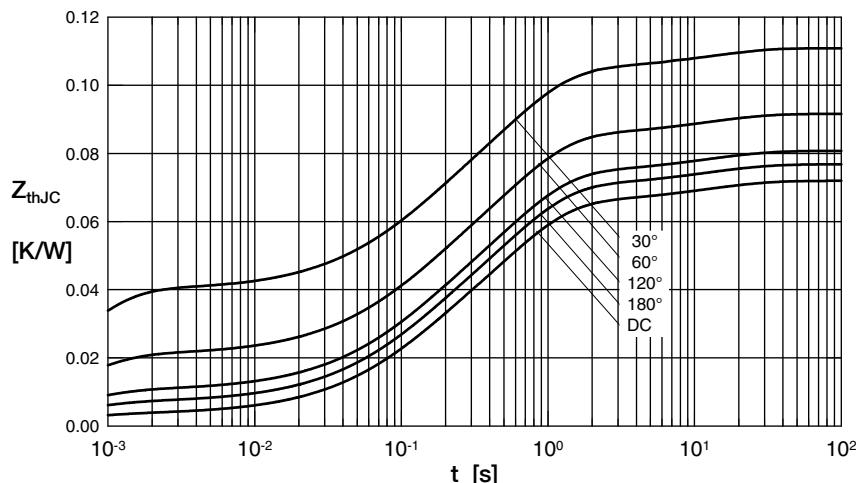


Fig. 9 Transient thermal impedance junction to case

R_{thJC} for various conduction angles d:

d	R_{thJC} (K/W)
DC	0.072
180°	0.0768
120°	0.081
60°	0.092
30°	0.111

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0035	0.00054
2	0.0186	0.098
3	0.0432	0.54
4	0.0067	12

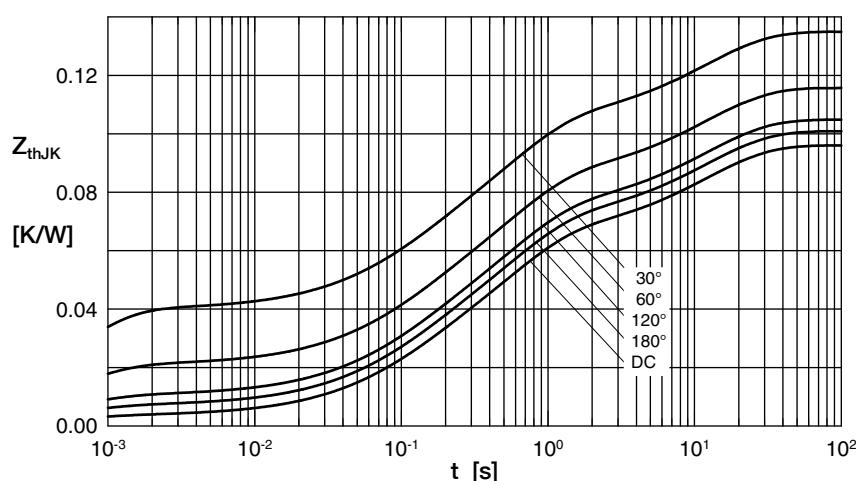


Fig.10 Transient thermal impedance junction to heatsink

R_{thJK} for various conduction angles d:

d	R_{thJK} (K/W)
DC	0.096
180°	0.1
120°	0.105
60°	0.116
30°	0.135

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0035	0.0054
2	0.0186	0.098
3	0.0432	0.54
4	0.0067	12
5	0.024	12



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331